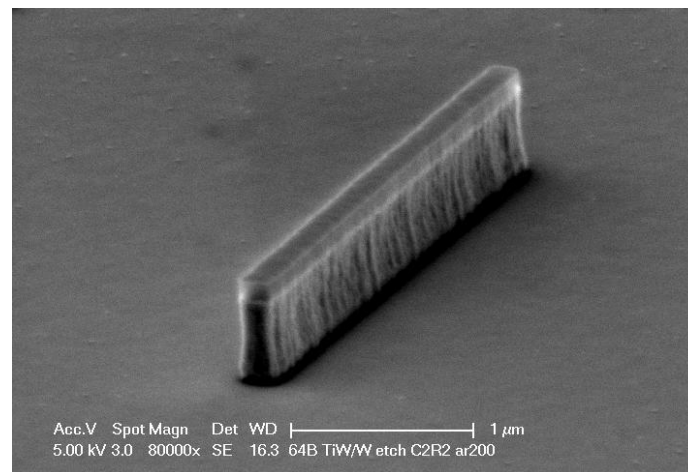


Recipe No. 161 on ICP#1 (named RODWELL).

	LIMIT	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5	Step 6
BCI3	20%	0	0	0	0	0	0
Cl2	20%	0	0	0	0	0	0
SF6	20%	20	20	20	0	0	0
O2	20%	0	0	0	0	0	0
Ar	20%	5	5	5	0	0	0
N2	20%	0	0	0	50	50	0
Pre.	20%	2	1	1	2	2.5	0
VACING TM		0:00	0:00	1:00	0:00	1:00	0:00
RF WAIT TM		0:10	0:00	0:00	0:15	0:00	0:00
SRC FWD	20%	600	600	600	100	50	0
SRC REF	20W						
BIAS FWD	20%	0	0	200	0	0	0
BIAS REF	20W						
DEAD TIME		0:05	0:05	0:05	0:10	0:05	0:00
EPM		None	None	None	None	None	None
STEP TIME		0:05	0:05		0:10	0:05	0:00
OVER ETCH %		0%	0%	0%	0%	0%	0%
OVER ETCH		0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
START F/R - 30.0 - SCCM He EXHST PR. - 30.0 - Pa							
C-He F/R		20	20	20	0	0	0
C-He Pre.		700	700	700	0	0	0
ESC		YES	YES	YES	NO	NO	NO
ESCVOLT1		1200	1200	1200	0	0	0
ESCVOLT2		-1200	-1200	-1200	0	0	0

~600nm etched W/TiW stack
 ~300nm/300nm
 3m35s high p + 40s low p
 ER ~ 160 nm/min
 Cr hard mask selectivity ~ 20:1



J. Rode

	LIMIT	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5	Step 6
BCl3	20%	0	0	0	0	0	0
Cl2	20%	0	0	0	0	0	0
SF6	20%	5	5	5	0	0	0
O2	20%	0	0	0	0	0	0
Ar	20%	5	5	5	0	0	0
N2	20%	0	0	0	50	50	0
Pre.	20%	1	0.5	0.5	2	2.5	0
VACING TM		0:00	0:00	1:00	0:00	1:00	0:00
RF WAIT TM		0:10	0:00	0:00	0:15	0:00	0:00
SRC FWD	20%	600	600	600	100	50	0
SRC REF	20W						
BIAS FWD	20%	0	0	15	0	0	0
BIAS REF	20W						
DEAD TIME		0:05	0:05	0:05	0:05	0:05	0:00
EPM		None	None	None	None	None	None
STEP TIME		0:05	0:05		0:05	0:05	0:00
OVER ETCH %		0%	0%	0%	0%	0%	0%
OVER ETCH		0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
START F/R - 30.0 - SCCM He EXHST PR. - 30.0 - Pa							
C-He F/R		20	20	20	0	0	0
C-He Pre.		700	700	700	0	0	0
ESC		YES	YES	YES	NO	NO	NO
ESCVOLT1		1200	1200	1200	0	0	0
ESCVOLT2		-1200	-1200	-1200	0	0	0